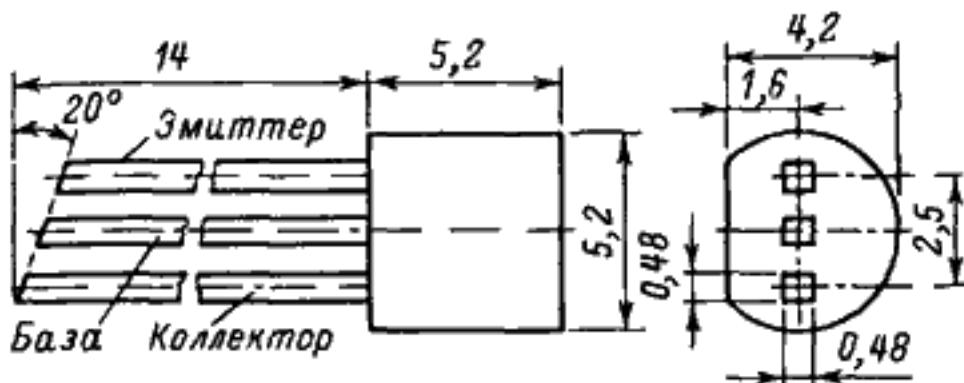


КТ502А, КТ502Б, КТ502В, КТ502Г, КТ502Д, КТ502Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* универсальные низкочастотные маломощные

Предназначены для работы в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах



Электрические параметры

Границное напряжение при $I_E = 10$ мА, $t_u \leq 30$ мкс, $Q \geq 100$
не менее

KT502А, KT502Б	25 В
KT502В, KT502Г	40 В
KT502Д	60 В
KT502Е	80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА,
 $I_B = 1$ мА не более

0,6 В

типовое значение

0,15* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА,

$I_B = 1$ мА не более

1,2 В

типовое значение

0,8* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим

эмиттером при $U_{KE} = 5$ В, $I_E = 10$ мА

KT502А, KT502В, KT502Д, KT502Е	40 – 120
KT502Б, KT502Г	80 – 240

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме

с общим эмиттером при $U_{KE} = 5$ В, $I_E = 3$ мА, $f = 1$ МГц

не менее

5 МГц

Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 5$ В $f = 465$ кГц

не более

20 пФ

Обратный ток коллектора при $U_{KB} = U_{KB\max}$ не бо-

лее

1 мкА

Пределные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база при $T =$
= 233 – 358 К

KT502А, KT502Б	40 В
KT502В, KT502Г	60 В
KT502Д	80 В
KT502Е	10 В

Постоянное напряжение база-эмиттер при $T =$
= 233 – 358 К

5 В

Постоянный ток коллектора при $T = 233 – 358$ В

0,15 А

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 10$ мс,

$Q \geq 100$, $T = 233 – 358$ К

0,35 А

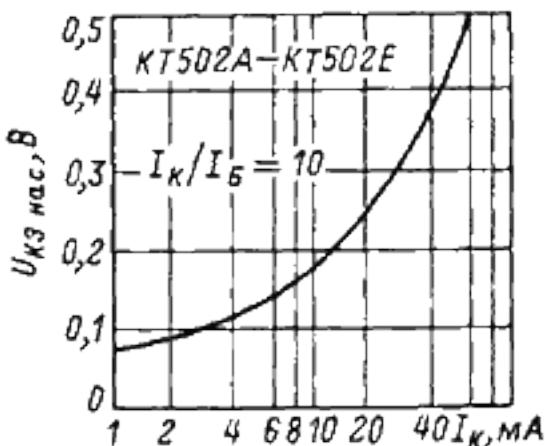
Постоянный ток базы при $T = 233 – 358$ В

0,1 А

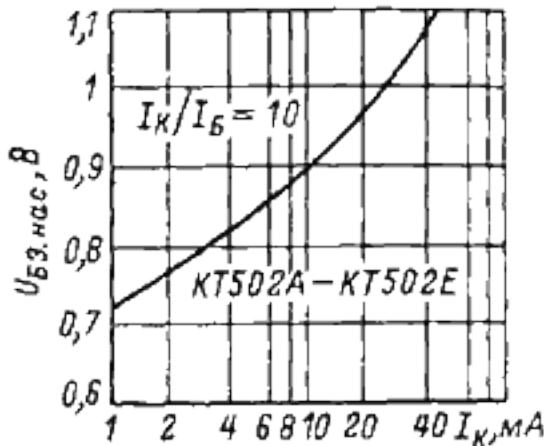
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при

$T = 233 – 298$ К

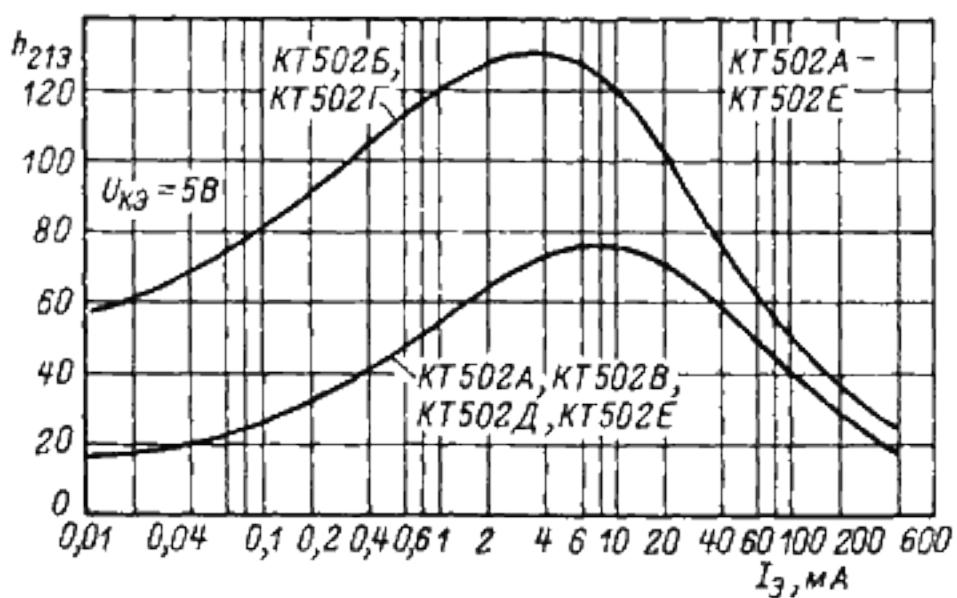
0,35 Вт



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.